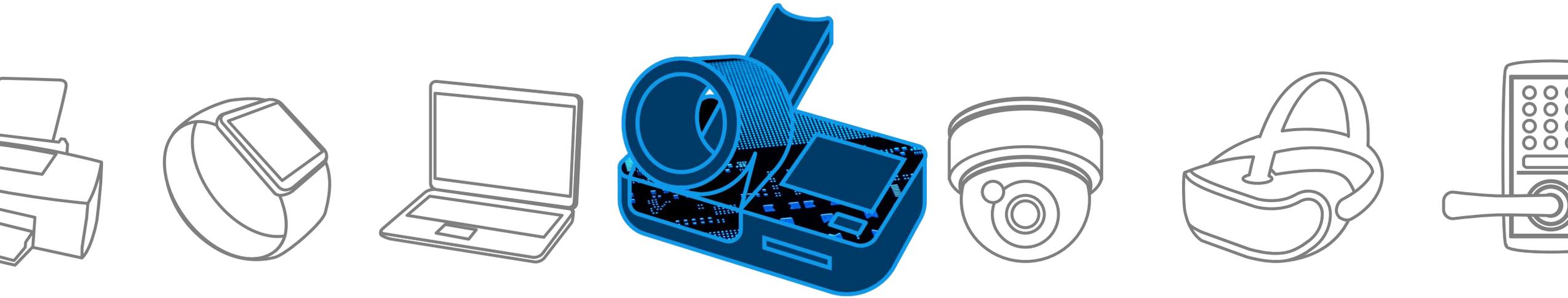


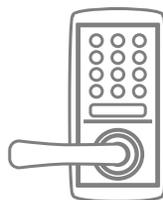
TOSHIBA

Electronic Sphygmomanometer

R21

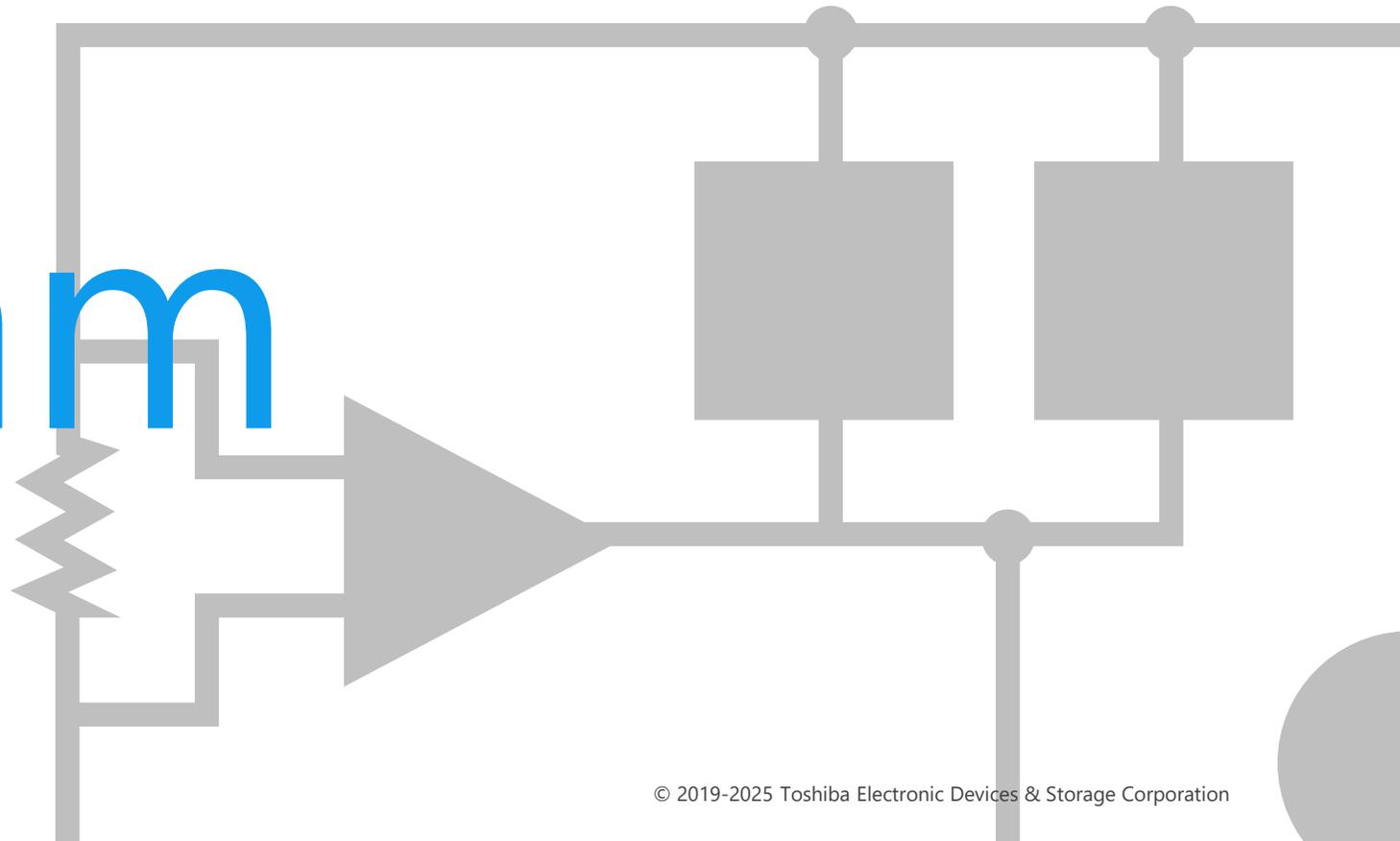
Solution Proposal by Toshiba



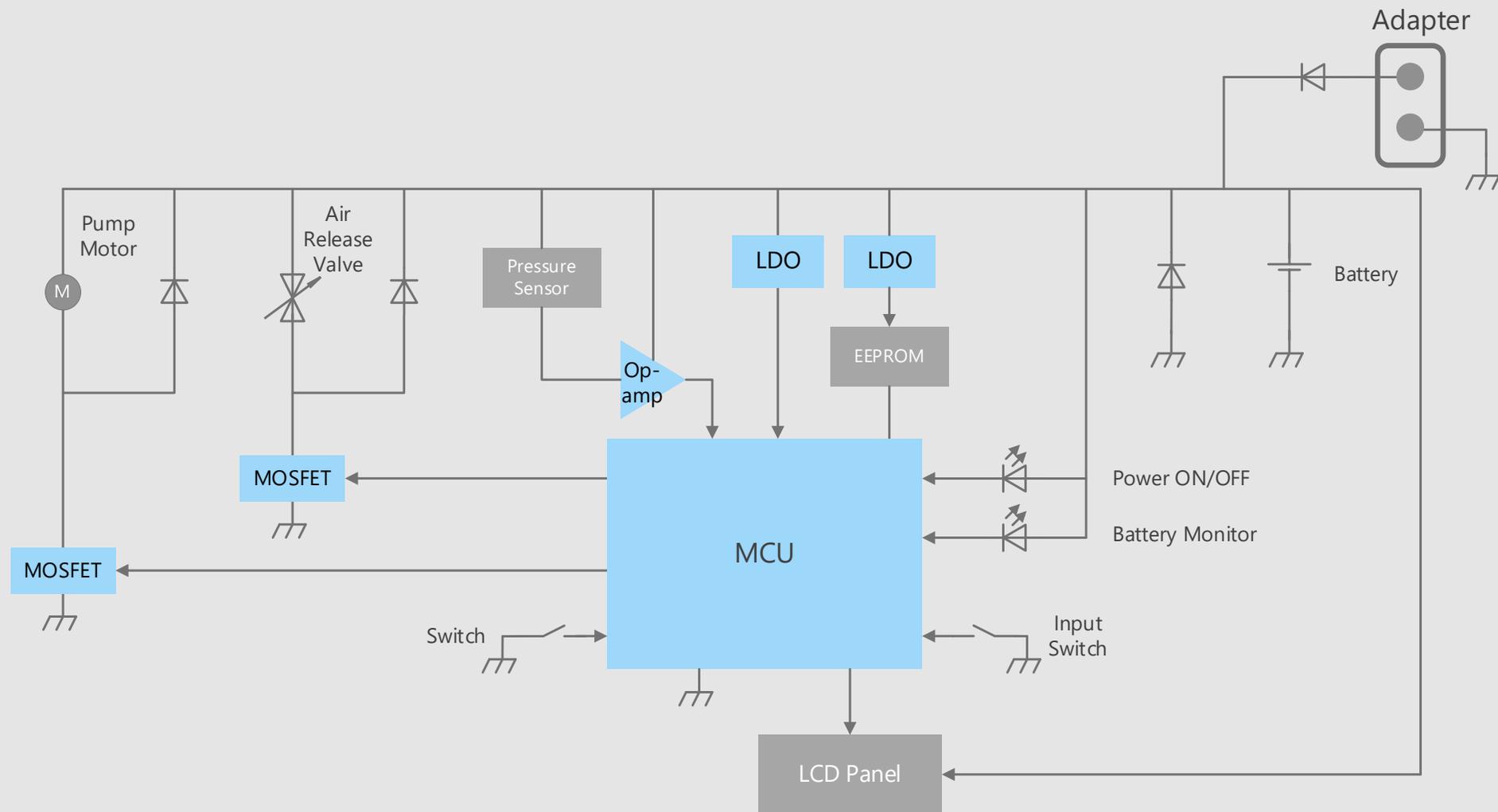


東芝デバイス&ストレージ株式会社では
既存セット設計の深い理解などにより、
新しくセット設計を考えられているお客様へ、
より適したデバイスソリューションをご提供したいと考えています。

Block Diagram

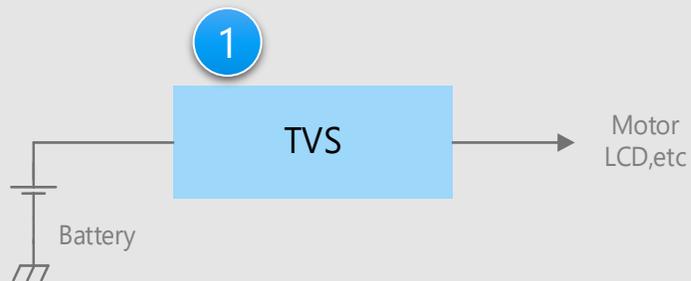


血圧計 全体ブロック図

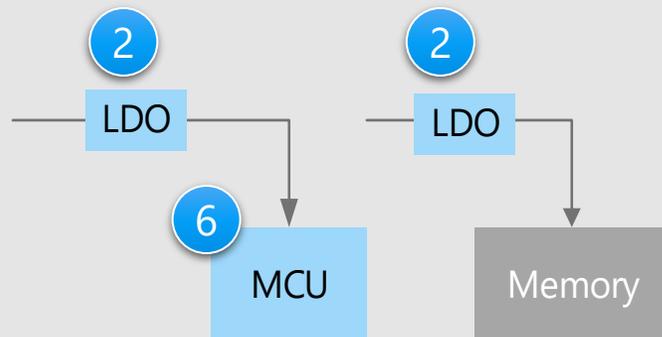


血圧計 電源部詳細

サージ電圧保護



制御用MCU電源



定電圧供給回路



※回路図内の番号をクリックすると、詳細説明ページに飛びます

デバイス選定のポイント

- ACアダプターからの電源ラインにはサージ電圧に対する保護が必要です。
- PSRR (電源電圧変動除去比) はMCUにとって重要な特性です。
- バッテリーとACアダプター間には逆流防止対策が必要です。

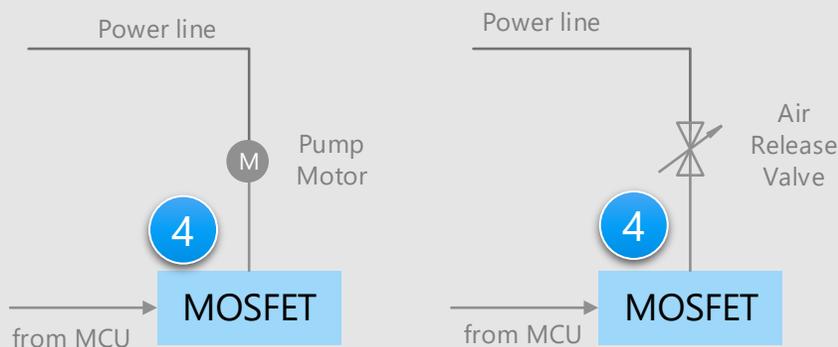
東芝からの提案

- 外部端子から侵入する静電気 (ESD) を吸収し、回路の誤動作、素子破壊を防止
TVSダイオード ①
- 低ノイズで電源を供給
小型面実装LDOレギュレーター ②
- 順電圧が低く、サージ電流に強い
ショットキーバリアダイオード ③
- LCDドライバー/コントローラー内蔵MCU
MCU ⑥

モーター保護



モーター制御



※回路図内の番号をクリックすると、詳細説明ページに飛びます

デバイス選定のポイント

- モーターの制御には小型で低オン抵抗のMOSFETが使用されます。
- モーターによるフライバック電流に対する保護が必要です。

東芝からの提案

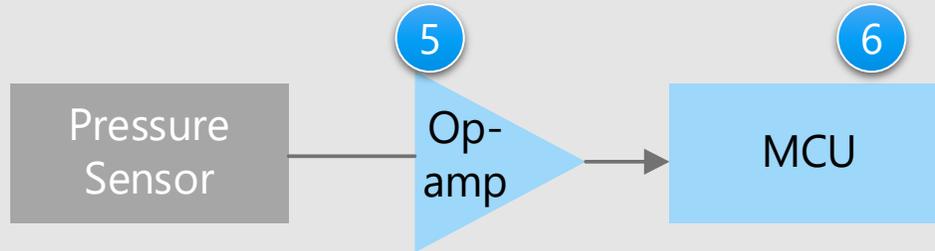
- 順電圧が低く、サージ電流に強い
ショットキーバリアダイオード
- 低オン抵抗で低消費電力のセットを実現
小信号MOSFET

3

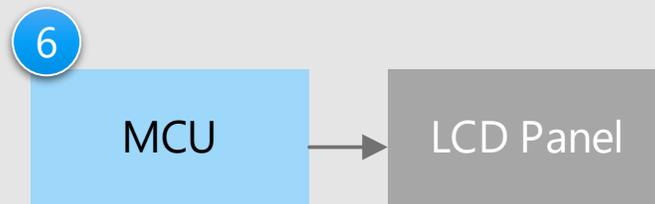
4

血圧計 センサー信号検出部詳細

圧力センサー



LCD ドライバー / コントローラー



※回路図内の番号をクリックすると、詳細説明ページに飛びます

デバイス選定のポイント

- 供給する電圧や電流はオペアンプ選定に重要です。
- 小型パッケージ品を採用することで基板面積を縮小できます。

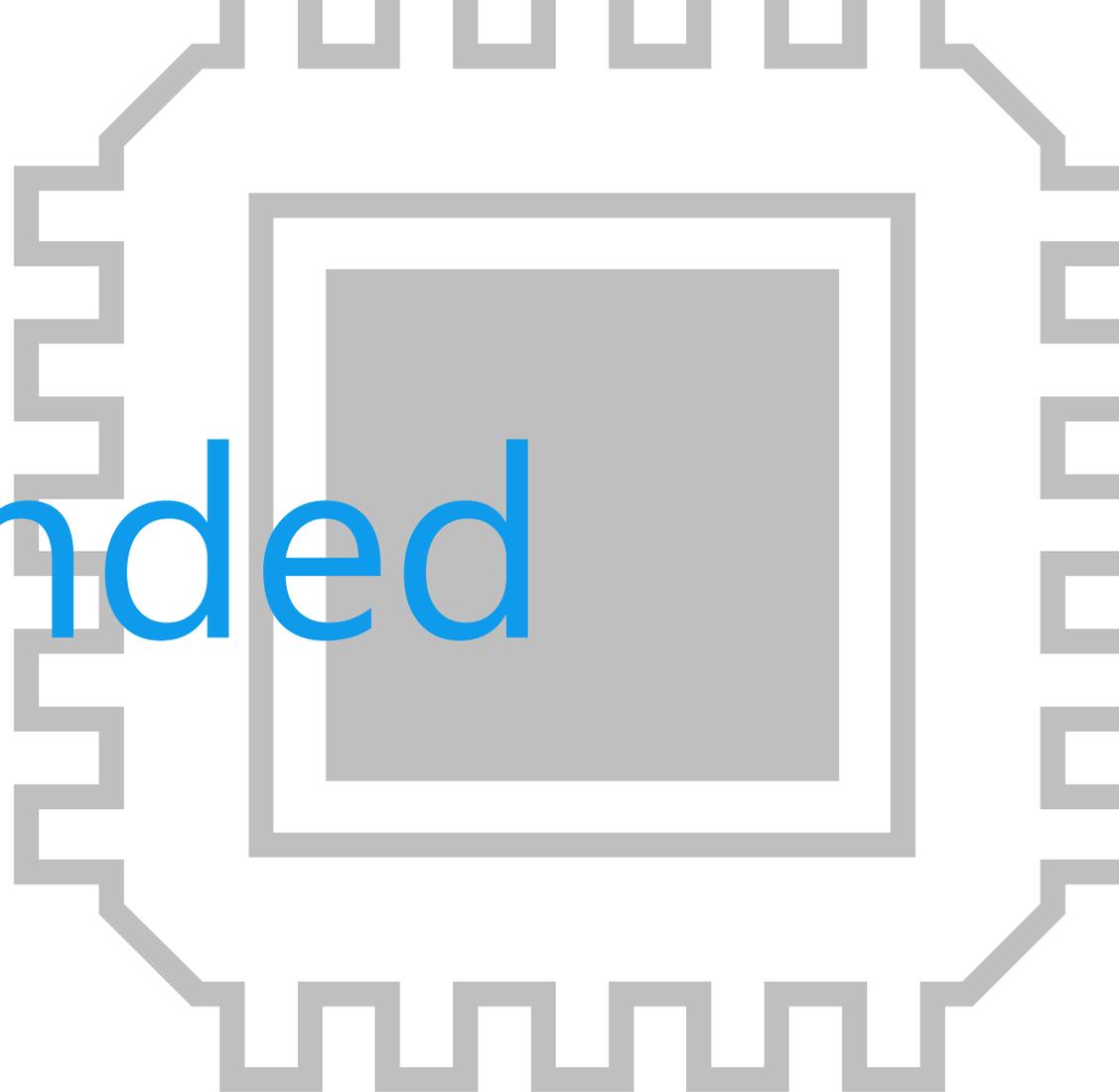
東芝からの提案

- 検出された小信号を低ノイズで増幅
低ノイズオペアンプ
- LCDドライバー/コントローラー内蔵MCU
MCU

5

6

Recommended Devices



以上のように、血圧計の設計には「**基板の小型化**」「**セットの低消費電力化**」「**堅牢な動作**」が重要であると考え、三つのソリューション視点から製品をご提案します。

基板の小型化



セットの低消費電力化



堅牢な動作



お客様の課題を解決するデバイスソリューション

小型
パッケージ
対応

高効率
・
低損失

ノイズ耐性

| | | | |
|--------------------|---|---|---|
| ① TVSダイオード | ● | | ● |
| ② 小型面実装LDOLレギュレーター | ● | ● | ● |
| ③ ショットキーバリアダイオード | ● | ● | ● |
| ④ 小信号MOSFET | ● | ● | |
| ⑤ 低ノイズオペアンプ | ● | | |
| ⑥ MCU | | ● | |

提供価値

外部端子から侵入する静電気（ESD）を吸収し、回路の誤動作防止、およびデバイスを保護します。

1 ESD吸収性を向上

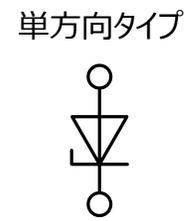
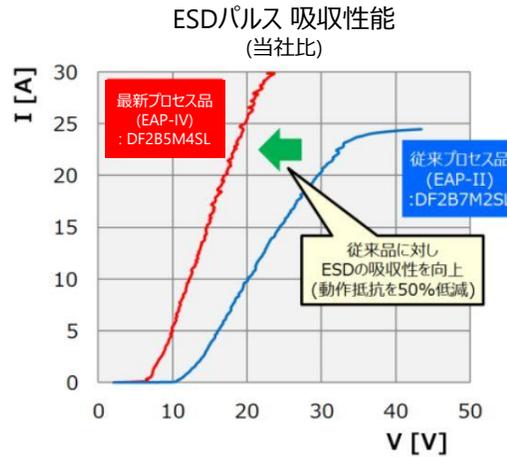
当社従来製品に対し、ESDの吸収性を向上しました。(動作抵抗を50%低減)
低動作抵抗と低容量を両立した製品もあり、高い信号保護性能と信号品質を確保します。

2 低クランプ電圧化によりESDエネルギーを抑制

独自の技術により、接続された回路や素子をしっかり保護します。

3 高密度実装に好適

多彩な小型パッケージをラインアップしています。



ロジック信号などの経路に最適
1in1、2in1、4in1、5in1、7in1品のラインアップがあります



オーディオ信号などプラスマイナス両極の信号がある経路に最適

| ラインアップ | | | | | |
|----------------------|----------|------------|----------|----------|----------|
| 品名 | DF2B7ASL | DF2B20M4SL | DF2B5PCT | DF2B7PCT | DF2B7AFU |
| パッケージ | SL2 | | | CST2 | USC |
| V_{ESD} [kV] | ±30 | ±15 | ±30 | ±30 | ±30 |
| V_{RWM} (Max) [V] | 5.5 | 18.5 | 3.6 | 5.5 | 5.5 |
| C_t (Typ.) [pF] | 8.5 | 0.2 | 41 | 45 | 8.5 |
| R_{DYN} (Typ.) [Ω] | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |

(注) 本製品はESD保護用ダイオードであり、ESD保護以外の用途には使用はできません。

[◆Block Diagram TOPへ戻る](#)

2 小型面実装LDOレギュレーター

TCR15AG / TCR13AG / TCR8BM / TCR5BM / TCR5RG / TCR3RM / TCR3U / TCR2L / TAR5シリーズ

小型
パッケージ
対応

高効率
・
低損失

ノイズ耐性

提供価値

高性能要求に適した製品を一般的な汎用タイプから小型パッケージまで幅広くラインアップしており、バッテリー電圧の変動に影響されず、安定した電源供給を実現します。

1 低ドロップアウト電圧

当社が独自に開発した最新世代プロセスにより、ドロップアウト特性を大幅に改善しました。

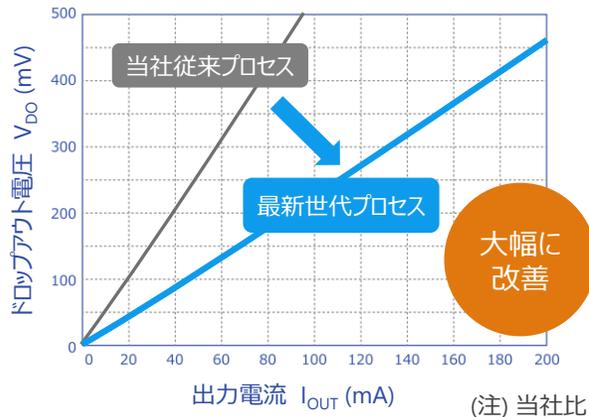
2 高PSRR 低出力雑音電圧

高いPSRR（Power Supply Rejection Ratio：電源電圧変動除去比）、低い出力雑音電圧 VNO を兼ね備えたシリーズを数多くラインアップしており、アナログ回路への安定電源に適しています。

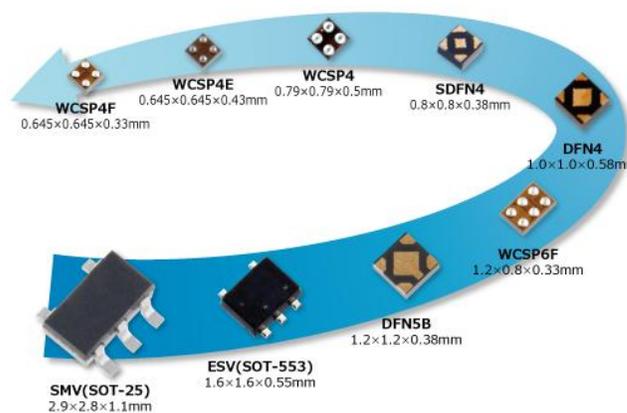
3 低消費電流特性

CMOSプロセスを用いて、独自の回路技術により消費電流 $I_{B(ON)} = 0.34 \mu A$ を実現しました。（TCR3Uシリーズ）

低ドロップアウト電圧



豊富なパッケージラインアップ



ラインアップ

| 品名 | TCR15AG シリーズ | TCR13AG シリーズ | TCR8BM シリーズ | TCR5BM シリーズ | TCR5RG シリーズ | TCR3RM シリーズ | TCR3U シリーズ | TCR2L シリーズ | TAR5 シリーズ |
|------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 特徴 | 低ドロップアウト 高PSRR | | | | 高PSRR 低ノイズ 低消費電流 | | 低消費電流 | | 入力電圧15V Bipolarタイプ |
| I_{OUT} (Max) [A] | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | | 0.2 | | |
| PSRR (Typ.) [dB] @f=1 kHz | 95 | 90 | 98 | 98 | 100 | 100 | 70 | - | 70 |
| I_B (Typ.) [μA] | 25 | 56 | 20 | 19 | 7 | 7 | 0.34 | 1 | 170 |

◆Block Diagram TOPへ戻る

提供価値

低損失でさまざまな用途に適用でき、小型化に貢献します。

1 低い順電圧

低順電圧であり、低損失で電源ラインの逆流防止用途に使用できます。

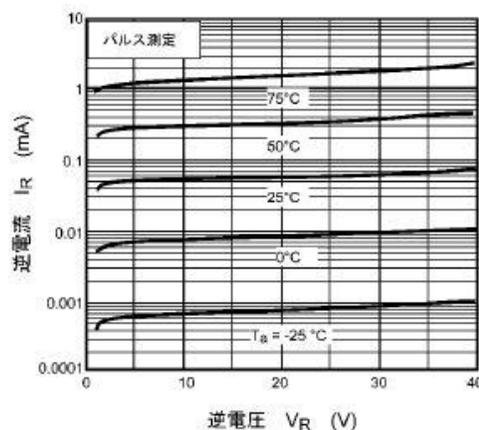
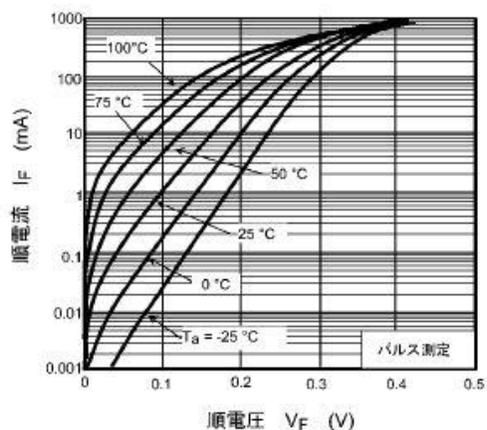
2 強い逆電圧

逆電圧 V_R は最大40 Vまで印加可能です。

3 小型パッケージ

小型パッケージで、高密度実装に適しています。

CUS10S40 特性図



ラインアップ

| 品名 | CUS10S40 | CUHS15F40 | CUS10F30 | 1SS424 |
|------------------|--|---|--|--|
| パッケージ | USC  | US2H  | USC  | ESC  |
| I_O (Max) [A] | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0.2 |
| V_R (Max) [V] | 40 | 40 | 30 | 20 |
| V_F (Typ.) [V] | 0.45 | 0.49 | 0.43 | 0.42 |

[◆Block Diagram TOPへ戻る](#)

提供価値

パワーマネジメントスイッチに適し、小型化に貢献します。

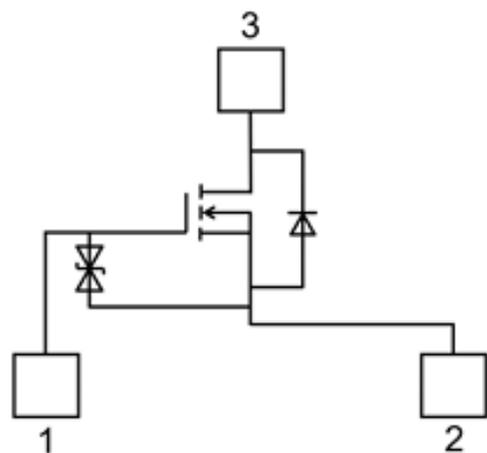
1 低電圧駆動

$V_{GS} = 1.8\text{ V}$ で駆動します。

2 低オン抵抗

ドレイン・ソース間のオン抵抗を低く抑えることで発熱と消費電力を低く抑えることができます。

SSM3K324R
内部接続図



ラインアップ

| 品名 | SSM3K324R | SSM3K35AMFV |
|---|---|--|
| パッケージ | SOT-23F  | VESM  |
| 極性 | N-ch | N-ch |
| V_{DS} [V] | 30 | 20 |
| I_D [A] | 4.0 | 0.25 |
| $R_{DS(ON)}$ (Max) [Ω] @ $V_{GS} = 1.8\text{ V}$ | 0.109 | 2.4 |

[◆Block Diagram TOPへ戻る](#)

提供価値

各種センサーで検出された微小信号を、低ノイズで増幅することが可能です。

1 低ノイズ

$V_{NI} = 6.0$ [nV/√Hz] (Typ.) @f = 1 kHz

各種センサー [注] で検出された微小信号を、低ノイズで増幅可能なCMOSオペアンプです。
プロセスの最適化で低入力換算雑音電圧を実現しました。

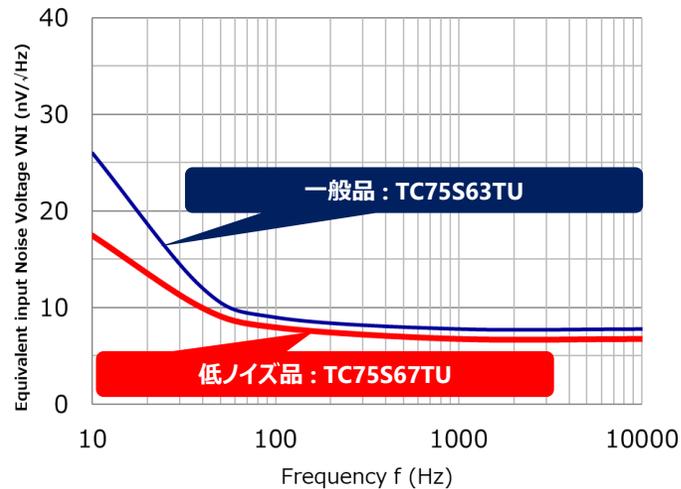
[注] 各種センサー: 振動検出センサーやショックセンサー、加速度センサー、圧力センサー、赤外線センサー、温度センサーなど。

2 低消費電流

$I_{DD} = 430$ [μA] (Typ.)

CMOSプロセスにより、低消費電流特性を実現しました。

ノイズ特性
(当社比)



ラインアップ

| 品名 | TC75S67TU |
|--|--|
| パッケージ | UFV  |
| V _{DD,SS} (Max) [V] | ±2.75 |
| V _{DD,SS} (Min) [V] | ±1.1 |
| I _{DD} (Typ.) [μA] | 430 |
| V _{NI} (Typ.) [nV/√Hz] @f = 1 kHz | 6 |

[◆Block Diagram TOPへ戻る](#)

提供価値

大容量124 KBのフラッシュメモリーやLCDドライバーを搭載した東芝オリジナルCPUコアの8ビットマイコンです。

1 東芝オリジナルコア TLCSTTM-870/C1シリーズ

TLCSTTM-870/C1シリーズは8bitでありながら、16bitと同等レベルの高速処理を実現、1命令サイクル1クロックで動作することにより、低い周波数で高速処理を実現しています。

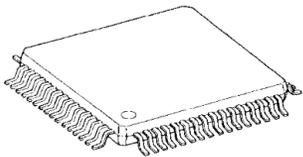
2 LCDドライバー / コントローラー 内蔵

LCDドライバー / コントローラーを内蔵し、セグメントLCDを直接駆動することが可能です。
1/4、1/3、1/2デューティー、スタティック駆動の選択が可能です。LCD電源電圧用ブリーダー抵抗も内蔵しています。

3 システムコスト / 開発負荷低減

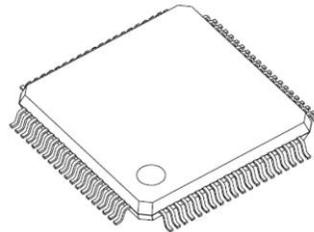
高周波発振回路 (Typ.:10 MHz) を内蔵し、システムコストの低減が可能です。
また東芝オリジナルNANOFLASHTMメモリー内蔵、プログラムの高速書き換えに対応しソフトウェア開発期間を短縮できます。

TMP89FW20AUG



LQFP64

TMP89FW24AFG



LQFP80

ラインアップ

| 品名 | TMP89FW20AUG | TMP89FW24AFG |
|---------|--|--|
| 最大動作周波数 | 16 MHz | 16 MHz |
| 命令ROM | 124 KB | 124 KB |
| RAM | 3 KB | 3 KB |
| Timer | 16bit x 2ch 10bit x 1ch 8bit x 4ch | 16bit x 2ch 10bit x 1ch 8bit x 4ch |
| UART | 3ch | 3ch |
| LCDD | 32 SEG x 4 COM | 40 SEG x 4 COM |
| ADC | 8ch (10bit) | 8ch (10bit) |

[◆Block Diagram TOPへ戻る](#)

製品にご興味をもたれた方、
ご意見・ご質問がございます方、
以下連絡先までお気軽にご連絡ください

連絡先：<https://toshiba.semicon-storage.com/jp/contact.html>



ご利用規約

本規約は、お客様と東芝デバイス&ストレージ株式会社（以下「当社」といいます）との間で、当社半導体製品を搭載した機器を設計する際に参考となるドキュメント及びデータ（以下「本リファレンスデザイン」といいます）の使用に関する条件を定めるものです。お客様は本規約を遵守しなければなりません。

第1条 禁止事項

お客様の禁止事項は、以下の通りです。

1. 本リファレンスデザインは、機器設計の参考データとして使用されることを意図しています。信頼性検証など、それ以外の目的には使用しないでください。
2. 本リファレンスデザインを販売、譲渡、貸与等しないでください。
3. 本リファレンスデザインは、高温・多湿・強電磁界などの対環境評価には使用できません。
4. 本リファレンスデザインを、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用しないでください。

第2条 保証制限等

1. 本リファレンスデザインは、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。
2. 本リファレンスデザインは参考用のデータです。当社は、データ及び情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。
3. 半導体素子は誤作動したり故障したりすることがあります。本リファレンスデザインを参考に機器設計を行う場合は、誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウェア・ソフトウェア・システムに必要な安全設計を行うことをお願いします。また、使用されている半導体素子に関する最新の情報（半導体信頼性ハンドブック、仕様書、データシート、アプリケーションノートなど）をご確認の上、これに従ってください。
4. 本リファレンスデザインを参考に機器設計を行う場合は、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断して下さい。当社は、適用可否に対する責任は負いません。
5. 本リファレンスデザインは、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証又は実施権の許諾を行うものではありません。
6. 当社は、本リファレンスデザインに関して、明示的にも黙示的にも一切の保証（機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の権利の非侵害保証を含むがこれに限らない。）をせず、また当社は、本リファレンスデザインに関する一切の損害（間接損害、結果的損害、特別損害、付随的損害、逸失利益、機会損失、休業損害、データ喪失等を含むがこれに限らない。）につき一切の責任を負いません。

第3条 契約期間

本リファレンスデザインをダウンロード又は使用することをもって、お客様は本規約に同意したものとみなされます。本規約は予告なしに変更される場合があります。当社は、理由の如何を問わずいつでも本規約を解除することができます。本規約が解除された場合は、お客様は本リファレンスデザインを破棄しなければなりません。さらに当社が要求した場合には、お客様は破棄したことを証する書面を当社に提出しなければなりません。

第4条 輸出管理

お客様は本リファレンスデザインを、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事用途の目的で使用してはなりません。また、お客様は「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」等、適用ある輸出関連法令を遵守しなければなりません。

第5条 準拠法

本規約の準拠法は日本法とします。

第6条 管轄裁判所

本リファレンスデザインに関する全ての紛争については、別段の定めがない限り東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

製品取り扱い上のお願い

東芝デバイス&ストレージ株式会社およびその子会社ならびに関係会社を以下「当社」といいます。
本資料に掲載されているハードウェア、ソフトウェアおよびシステムを以下「本製品」といいます。

- 本製品に関する情報等、本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。
- 文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。また、文書による当社の事前の承諾を得て本資料を転載複製する場合でも、記載内容に一切変更を加えたり、削除したりしないでください。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体・ストレージ製品は一般に誤作動または故障する場合があります。本製品をご使用頂く場合は、本製品の誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウェア・ソフトウェア・システムに必要な安全設計を行うことをお願いします。なお、設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報（本資料、仕様書、データシート、アプリケーションノート、半導体信頼性ハンドブックなど）および本製品が使用される機器の取扱説明書、操作説明書などをご確認の上、これに従ってください。また、上記資料などに記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を使用する場合は、お客様の製品単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
- 本製品は、特別に高い品質・信頼性が要求され、またはその故障や誤作動が生命・身体に危害を及ぼす恐れ、膨大な財産損害を引き起こす恐れ、もしくは社会に深刻な影響を及ぼす恐れのある機器（以下“特定用途”という）に使用されることは意図されていませんし、保証もされていません。特定用途には原子力関連機器、航空・宇宙機器、医療機器（ヘルスケア除く）、車載・輸送機器、列車・船舶機器、交通信号機器、燃焼・爆発制御機器、各種安全関連機器、昇降機器、発電関連機器などが含まれますが、本資料に個別に記載する用途は除きます。特定用途に使用された場合には、当社は一切の責任を負いません。なお、詳細は当社営業窓口まで、または当社Webサイトのお問い合わせフォームからお問い合わせください。
- 本製品を分解、解析、リバースエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製等しないでください。
- 本製品を、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用することはできません。
- 本資料に掲載してある技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 別途、書面による契約またはお客様と当社が合意した仕様書がない限り、当社は、本製品および技術情報に関して、明示的にも黙示的にも一切の保証（機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の権利の非侵害保証を含むがこれに限らない。）をしておりません。
- 本製品にはGaAs（ガリウムヒ素）が使われているものがあります。その粉末や蒸気等は人体に対し有害ですので、破壊、切断、粉碎や化学的な分解はしないでください。
- 本製品、または本資料に掲載されている技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」等、適用ある輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
- 本製品のRoHS適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問い合わせください。本製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS指令等、適用ある環境関連法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。

TOSHIBA

* NANOFLASH™、TLCST™は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。

* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。